

DOUBLE-DIODE PENTODE with variable mutual conductance for use as R.F., I.F. and A.F. amplifier

DOUBLE-DIODE-PENTHODE à pente variable pour utilisation en amplificatrice H.F., M.F. et B.F.

DOPPELDIODE-PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als HF-, ZF- und NF-Verstärker

Heating : indirect by A.C. or D.C.; series or parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; alimentation en parallèle ou en série

Heizung : indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serien- oder Parallelspeisung

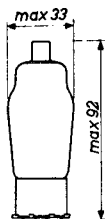
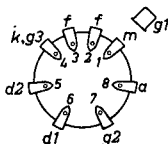
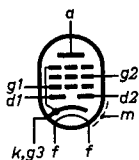
$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I_f = 0,2 \text{ A}$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: P

Capacitances

Capacités

Kapazitäten

$C_{g1}$	=	4,4 pF	$C_{d1g1}$	<	0,0005 pF
$C_a$	=	8,6 pF	$C_{d2g1}$	<	0,0005 pF
$C_{ag1}$	<	0,002 pF	$C_{(d1+d2)g1}$	<	0,001 pF
$C_{g1f}$	<	0,01 pF	$C_{d1a}$	<	0,3 pF
$C_{d1}$	=	3 pF	$C_{d2a}$	<	0,25 pF
$C_{d2}$	=	3 pF	$C_{(d1+d2)a}$	<	0,4 pF
$C_{d1d2}$	<	0,3 pF			

Operating characteristics of the pentode section  
 Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode  
 Betriebsdaten des Pentodenteiles

$V_a$	=	100		200		250	V
$R_{g2}$	=	-		60		95	k $\Omega$
$R_k$	=	300		300		300	$\Omega$
$V_{g1}$	=	-2	-16,5	-2	-32,5	-2	-38 V
$V_{g2}$	=	100	100	100	200	100	250 V
$I_a$	=	5	-	5	-	5	mA
$I_{g2}$	=	1,6	-	1,6	-	1,6	mA
$S$	=	1800	18	1800	18	1800	18 $\mu$ A/V
$R_1$	=	0,4	>10	1,0	>10	1,3	>10 M $\Omega$

Limiting values of the pentode section  
 Caractéristiques limites de la partie penthode  
 Grenzdaten des Pentodenteiles

$V_{a0}$	= max.	550 V
$V_a$	= max.	300 V
$W_a$	= max.	1,5 W
$V_{g20}$	= max.	550 V
$V_{g2}$ ( $I_a = 5$ mA)	= max.	125 V
$V_{g2}$ ( $I_a < 2$ mA)	= max.	300 V
$W_{g2}$	= max.	0,3 W
$I_k$	= max.	10 mA
$V_{g1}$ ( $I_{g1} = +0,3$ $\mu$ A)	= max.	-1,3 V
$R_{g1}$	= max.	3 M $\Omega$
$R_{kf}$	= max.	20 k $\Omega$
$V_{kf}$	= max.	100 V

Limiting values of the diode section (each section)  
 Caractéristiques limites de la partie diode  
 (par système)  
 Grenzdaten des Diodenteiles (pro System)

$V_d$ inv <sub>p</sub>	= max.	350 V
$I_d$	= max.	0,8 mA
$I_{d_p}$	= max.	5 mA
$R_{kf}$	= max.	20 k $\Omega$
$V_{kf}$	= max.	100 V

**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

<b>page</b>	<b>EBF2 sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1953.04.04
2	2	1953.04.04
3	FP	1999.06.15